



NMOS 数据手册

NP100S030P56A

30V 100A Advanced Trench NMOS
Rev. 1.2

请注意以下有关宁波宝芯源功率半导体知识产权政策

* 宁波宝芯源功率半导体有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

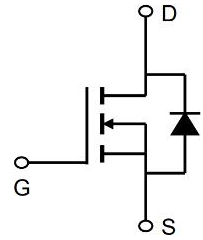
* 宁波宝芯源功率半导体有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 www.pwcore.com。

NMOS 30V/100A NP100S030P56A

产品特性 Features

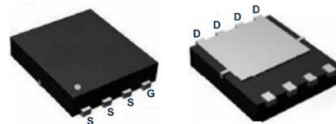
- ◆ 先进沟槽工艺技术 Advanced Trench Technology
- ◆ 超低栅极电荷 Super Low Gate Charge
- ◆ 超低 Ron 高密度单元设计 High Density Cell Design for Ultra Low Rdson
- ◆ RoHS 产品 RoHS Product



应用领域 Applications

- ◆ 负载开关 Load Switching
- ◆ 脉宽调制器 PWM
- ◆ DC/DC 转换器 DC/DC Converter
- ◆ 高频开关 High Frequency Switching

关键参数与封装信息 Key Performance and Package Parameters



PDFN5x6

产品型号 Part No.	封装 Package	漏极-源极电压 V_{DS}	漏极电流 I_D	导通电阻 $R_{DS(on)}$ Typ.
NP100S030P56A	PDFN5X6	30V	100A	2.4m Ω @ $V_{GS}=10V$

最大额定值 Maximum Ratings

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit
最高漏极-源极直流电压 Drain to Source Voltage	V_{DS}	30	V
最高栅源电压 Gate to Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
连续漏极电流 Drain Current-Continuous, Limited by T_{vjmax} TC = 25° C TC = 100° C	I_D	100 63	A
最大脉冲漏极电流 Pulse Drain Current $PW \leq 300 \mu s, Duty\ Cycle \leq 2\%$	I_{Dpuls}	200	A
二极管正向电流 Diode Forward Current, Limited by T_{vjmax} TC = 25° C	I_S/I_{SM}	100/200	A
单脉冲雪崩能量 Single Pulsed Avalanche Energy ^②	EAS	144	mJ
最大耗散功率 Maximum Power Dissipation TC = 25° C TC = 100° C	P_D	73.5 29.4	W
结温 Operating Junction Temperature	T_J	-55...+150	° C
存储温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55...+150	° C
最高焊接温度 Maximum Soldering Temperature		260	° C

① 脉冲宽度由最高结温限制 Pulse width limited by maximum junction temperature

② EAS 测试条件: $T_J=25^\circ C$, $V_{DD}=25V$, $I_{AR}=24A$, $L=0.5mH$, $R_g=25\Omega$

热阻特性 Thermal Resistance

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 (最大) Max. Value	单位 Unit
结到管壳热阻 Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	1.7	° C /W
结到环境热阻 Thermal Resistance Junction to Ambient ^③	$R_{\theta JA}$	50	° C /W

③ Device on 40mm x 40mm x 1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm² (one layer, 7μm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical in still air.

电气特性 Electrical Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

项目 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Conditions	数值 Value			单位 Unit
			Min.	Typ.	Max.	
漏-源击穿电压 Drain to Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	30	-	-	V
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$ $T_J=25^\circ C$ $T_J=150^\circ C$	-	-	1 100	μA
栅极漏电流 Gate to Source Leakage Current	I_{GSS}	$V_{DS}=0V, V_{GS}=\pm 20V$	-	-	± 100	nA
阈值电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	1.0	-	2.2	V
静态导通电阻 Drain to Source On-State Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=30A$	-	2.4	3.1	m Ω
		$V_{GS}=4.5V, I_D=15A$	-	3.7	5.1	m Ω
正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$I_S=30A, V_{GS}=0V$	-	0.8	1.4	V
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=15V$ $V_{GS}=0V$ $f=1MHz$	-	2.2	-	nF
输出电容 Output Capacitance	C_{oss}		-	1.1	-	pF
反向传输电容 Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		-	50.1	-	pF
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS}=15V$ $V_{GS}=10V$ $I_{DS}=15A$	-	34.5	-	nC
栅极-源极电荷 Gate to Source Charge	Q_{gs}		-	6.1	-	
栅极-漏极电荷 Gate to Drain Charge	Q_{gd}		-	7.8	-	
开启延迟时间 Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$T_J=25^\circ C$ $V_{DD}=20V, I_{DS}=15A,$ $V_{GS}=10V, R_G=1\Omega$	-	16	-	ns
上升时间 Rise Time	t_r		-	10	-	
关断延迟时间 Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$		-	40	-	
下降时间 Fall Time	t_f		-	12	-	
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=15A,$ $di/dt=100A/\mu s$	-	38	-	ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}		-	28	-	nC

特征曲线 Characteristic Curve

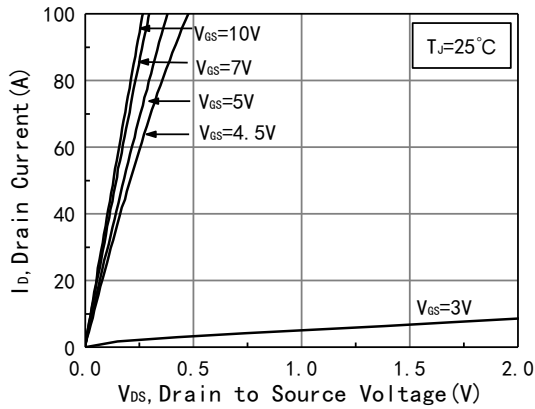


Figure 1. Typical Output Characteristics

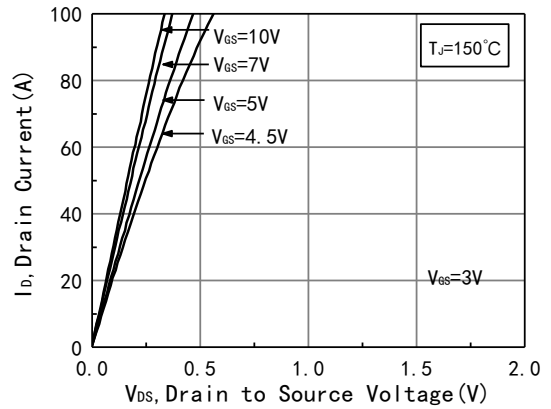


Figure 2. Typical Output Characteristics

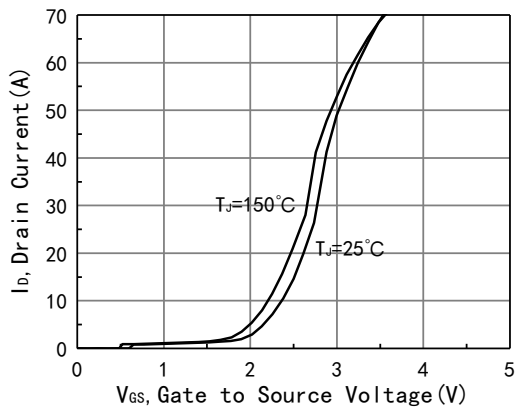


Figure 3. Typical Transfer Characteristics

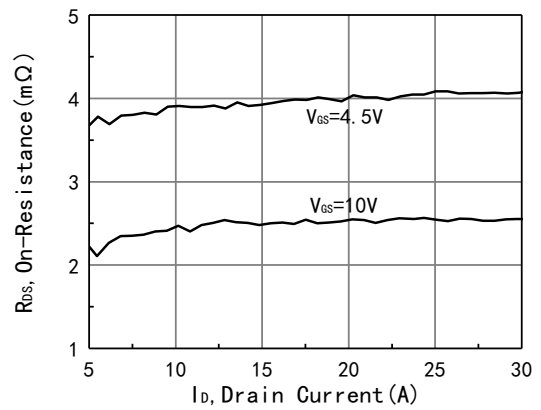


Figure 4. $R_{DS(on)}$ vs. I_D

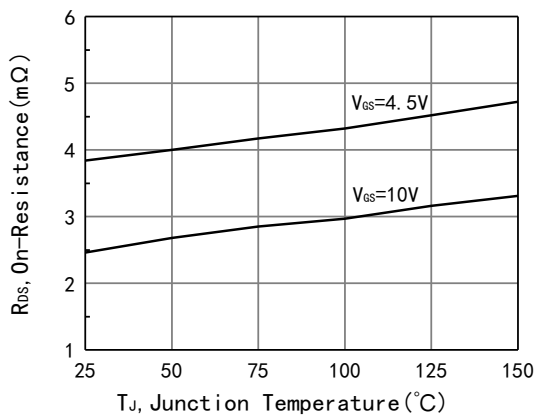


Figure 5. $R_{DS(on)}$ vs. T_J

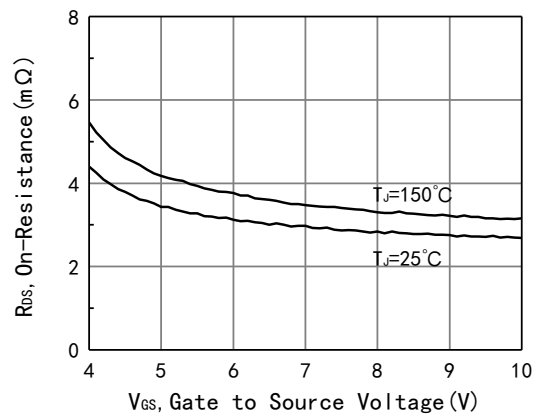


Figure 6. $R_{DS(on)}$ vs. V_{GS}

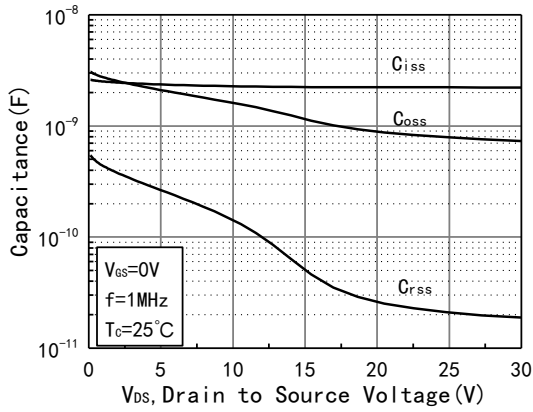


Figure 7. Capacitance vs. Vds

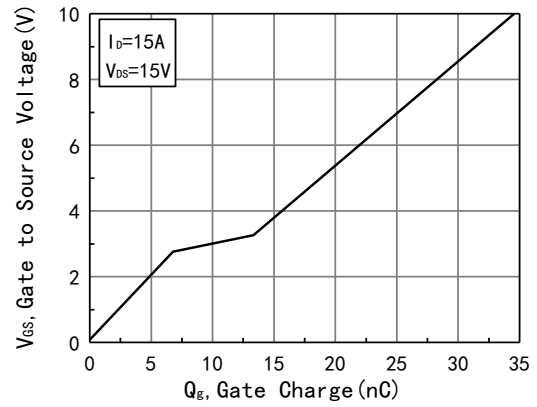


Figure 8. Gate Charge Characteristic

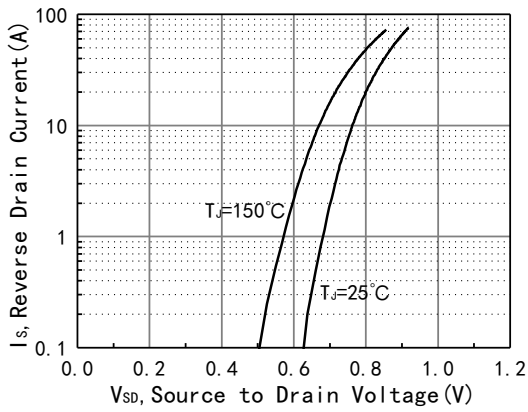


Figure 9. Diode Forward Characteristic

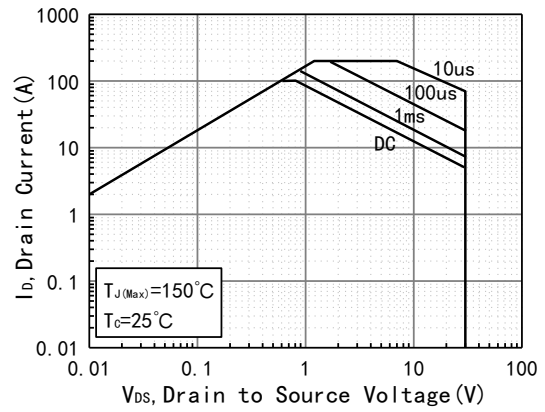


Figure 10. Safe Operating Area

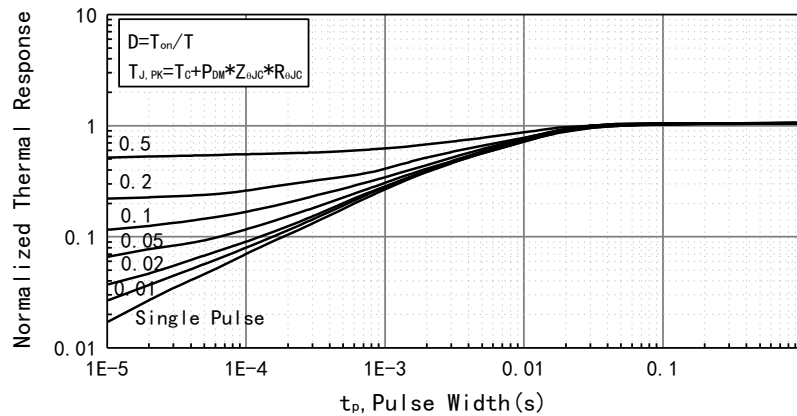
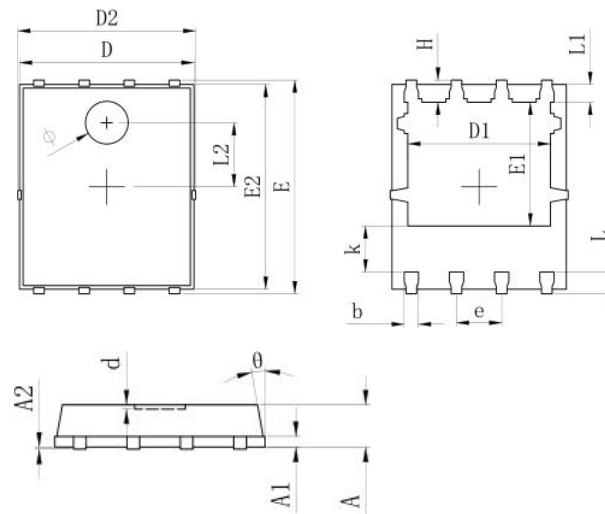


Figure 11. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

外形尺寸Mechanical Data:PFN5*6



Dimensions In Millimeterer			
Symbol	MIN	TYP	MAX
A	0.90	1.00	1.10
A1	0.254 REF.		
A2	0~0.05		
D	4.824	4.900	4.976
D1	3.910	4.010	4.110
D2	4.924	5.000	5.076
E	5.924	6.000	6.076
E1	3.375	3.475	3.575
E2	5.674	5.750	5.826
b	0.350	0.400	0.450
e	1.270 TYP.		
L	0.534	0.610	0.686
L1	0.424	0.500	0.576
L2	1.800 REF.		
k	1.190	1.290	1.390
H	0.549	0.625	0.701
θ	8°	10°	12°
ϕ	1.10	1.20	1.30
d	-	-	0.100

历史版本

版本号	时间	修改内容
V1.0	2021 年 11 月	初始版本
V1.1	2022 年 03 月	更新参数和曲线模板，更新 EAS 测试条件
V1.2	2022 年 07 月	更新 Ron,Vth spec，更新模板